

第二章.均匀物质的热力学性质

数学准备

雅克比行列式

知识梳理

麦氏关系推导

麦氏关系的应用

内能、焓的全微分

熵的全微分

重要结论

降温的两种途径

节流过程（焓守恒）

绝热膨胀过程（熵守恒）

基本热力学函数

内能、焓的基本方程

1mol理想气体的吉布斯函数

吉布斯-亥姆霍兹方程

热辐射理论

空窖辐射

可逆绝热辐射

磁介质热力学

忽略体积功

不忽略体积功

内容补充

广义功

物态方程

第二章.均匀物质的热力学性质

数学准备

雅克比行列式

设 $u=u(x,y)$, $v=v(x,y)$, 雅克比定义:

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial x}$$

性质:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_y = \frac{\partial(u, y)}{\partial(x, y)}$$

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = -\frac{\partial(v, u)}{\partial(x, y)}$$

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, s)} \frac{\partial(x, s)}{\partial(x, y)}$$

知识梳理

- 自变量：S、P、V、T
- 状态函数：U、H、F、G
- 基本方程

$$dU = TdS - PdV$$

$$dH = TdS + VdP$$

$$dF = -SdT - PdV$$

$$dG = -SdT + VdP$$

- 状态函数组合：
 - $U=U(S, V)$
 - $H=H(S, P)$
 - $F=F(T, V)$
 - $G=G(T, P)$
- 状态函数转化：

$$H = U + PV$$

$$F = U - TS$$

$$G = U - TS + PV$$

麦氏关系推导

根据四个基本方程

$$\begin{aligned}
dU &= TdS - PdV & \rightarrow & & T &= \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V & P &= -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S \\
dH &= TdS + VdP & \rightarrow & & T &= \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P & V &= \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S \\
dF &= -SdT - PdV & \rightarrow & & S &= -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V & P &= -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T \\
dG &= -SdT + VdP & \rightarrow & & S &= -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P & V &= \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T
\end{aligned}$$

由此我们可以给出去全微分的表达式：

$$\begin{aligned}
dU &= \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV \\
dH &= \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P dS + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S dP \\
dF &= \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T dV \\
dG &= \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T dP
\end{aligned}$$

通过二阶偏微分变换积分变量顺序相等，我们可以得到麦氏关系：

$$\begin{aligned}
\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S &= -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V \\
\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S &= \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P \\
\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T &= \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \\
\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T &= -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P
\end{aligned}$$

将上面的等式顺序与下面的方阵顺序进行对比，即可快速记忆

$$\begin{array}{cc}
P & T \\
S & V
\end{array}$$

麦氏关系的应用

内能、焓的全微分

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$$

为了求解这两个偏导数，我们考虑如下方程

$$\begin{aligned}
dU &= TdS - PdV \\
dS &= \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T dV
\end{aligned}$$

联立个式子可以得到

$$dU = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V dT + [T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T - P]dV$$

根据Cv和麦氏关系-3代入表达式：

$$dU = C_v dT + [T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P]dV$$

- 内能的积分表达式

$$U = \int C_v dT + \int [T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P]dV + U_0$$

- 焓的积分表达式（同理可得）

$$H = \int C_p dT + [V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P]dP + H_0$$

熵的全微分

当计算内能的时候，利用Cv和熵的关系；计算焓的时候，利用Cp和熵的关系：

$$C_v = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \quad C_p = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P$$

同时分别对应这两组变量表达 (s,t,v) \ (s,t,p)

$$dS = \left(\frac{C_v}{T}\right) \cdot dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \cdot dV$$

$$dS = \left(\frac{C_p}{T}\right) \cdot dT + \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T \cdot dP$$

代入麦氏关系3、4可以得到：

$$dS = \left(\frac{C_v}{T}\right) \cdot dT + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \cdot dV$$

$$dS = \left(\frac{C_p}{T}\right) \cdot dT - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \cdot dP$$

如此就可以得到了熵的全微分表达式，并且通过对应的物态方程可以求出熵

重要结论

- 理想气体的焦耳定律

$$\left(\frac{\partial U_m}{\partial V_m}\right)_T = 0 \quad \left(\frac{\partial U_m}{\partial P}\right)_T = 0$$

- 范式气体的焦耳定律

$$(p + \frac{a}{V_m^2})(V_m - b) = RT$$

$$(\frac{\partial U_m}{\partial V_m})_T = \frac{a}{V_m^2} \quad (\frac{\partial U_m}{\partial P})_T = b$$

- 热容的差

$$C_p - C_v = T(\frac{\partial P}{\partial T})_V(\frac{\partial V}{\partial T})_P = \frac{VT\alpha^2}{\kappa_T}$$

降温的两种途径

节流过程（焓守恒）

- 焦汤系数：表示焓不变的条件下气体温度随压强的变化率

$$\mu = (\frac{\partial T}{\partial P})_H$$

通过循环偏导的负值关系以及 C_p 、焓的全微分系数，不难推导得到：

$$\mu = \frac{V}{C_p}[T\alpha - 1]$$

对于理想气体而言 $\mu=0$ ，节流前后无温度变化；实际气体 $\mu>0$ 一侧为降温区， $\mu=0$ 为反转曲线；

绝热膨胀过程（熵守恒）

- 通过焦汤系数概念的迁移，我们可以得到熵守恒过程中的变化系数：

$$(\frac{\partial T}{\partial P})_S = \frac{VT\alpha}{C_p}$$

基本热力学函数

内能、焓的基本方程

- 对内能、焓的全微分，我们可以得到对应的积分表达式，以及对应的熵的积分表达式
- 等容热容表示内能、熵

$$U = \int C_v dT + \int [T(\frac{\partial P}{\partial T})_V - P] dV + U_0$$

$$S = \int (\frac{C_v}{T}) \cdot dT + \int (\frac{\partial P}{\partial T})_V \cdot dV + S_0$$

- 等压热容表示焓、熵

$$H = \int C_p dT + [V - T(\frac{\partial V}{\partial T})_P] dP + H_0$$

$$S = \int (\frac{C_p}{T}) \cdot dT - \int (\frac{\partial V}{\partial T})_P \cdot dP + S_0$$

- 对于吉布斯函数和自由能通过上面两个基本函数以及吉布斯-亥姆霍兹方程即可快速推导得到

1mol理想气体的吉布斯函数

- 表达形式1

$$G_m = \int C_{p,m} dT - T \int C_{p,m} \frac{dT}{T} + RT \ln P + H_{m0} - TS_{m0}$$

- 表达形式2

$$G_m = RT(\varphi + \ln P)$$

$$\varphi = \frac{H_{m0}}{RT} - \int \frac{dT}{T^2} \int C_{p,m} dT - \frac{S_{m0}}{R}$$

吉布斯-亥姆霍兹方程

- 通过基本方程以及基本微分方程系数关系不难得到

$$U = F + TS = F - T \frac{\partial F}{\partial T}$$

$$H = G - TS = G - T \frac{\partial G}{\partial T}$$

- 特性函数（均可以表征均匀系统的特性）：

- $U=U(S, V)$
- $H=H(S, P)$
- $F=F(T, V)$

$$\circ G=G(T, P)$$

热辐射理论

空窖辐射

- 辐射压强 p 与辐射能量密度 u 之间的关系：

$$p = \frac{1}{3}u \quad U(T, V) = u(T) \cdot V$$

辐射能量密度是只与温度有关的函数

- 空窖辐射的内能密度与绝对温度的四次方成正比

$$u = aT^4$$

对应的可以得到熵的表达式为：

$$S = \frac{4}{3}aT^3V$$

在窖壁熵开一个小孔，可以得到辐射铜梁密度 J_u 与辐射内能密度存在如下关系：

$$J_u = \frac{1}{4}cu = \frac{1}{4}caT^4 = \sigma T^4$$

其中 σ 为斯特藩常量，上面的等式称为斯特藩玻尔兹曼定律。

可逆绝热辐射

- 可逆绝热满足如下条件：

$$T^3V = Const.$$

由此我们不难推导得到吉布斯函数的结果：

$$G = 0$$

其对应的结论为平衡辐射光子数不守恒

磁介质热力学

- 前提知识

$$\delta W = Vd\left(\frac{1}{2}\mu_0 H^2\right) + \mu_0 VHdM$$

等式右边第一项为激发磁场所作的功，第二项是介质磁化所作的功，下面的过程中只考虑介质磁化的功即

$$\delta W = \mu_0 VHdM = \mu_0 Hdm$$

忽略体积功

在忽略体积功的情况下，我们可以得到：

$$\delta W = \mu_0 H dm$$

- 物理量的迁移

我们根据之前的广义功定义进行迁移，

$$p \rightarrow -\mu_0 H \quad V \rightarrow m$$

- 基本方程的迁移

$$\begin{aligned} dG &= -SdT - \mu_0 m dH \\ G &= U - TS - \mu_0 H m \end{aligned}$$

- 麦氏关系的迁移

将物理量直接替换进原来的麦氏关系即可，得到的关系应该是

$$\left(\frac{\partial (-\mu_0 H)}{\partial S} \right)_m = T$$

- 热容量的迁移

$$C_H = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_H$$

- 磁制冷（在满足居里定律的前提下）

- 居里定律

$$m = \frac{CV}{T} H$$

- 利用麦氏关系、循环微分关系、热容量定义，我们可以推导得到：

$$\left(\frac{\partial T}{\partial H} \right)_S = -\frac{\mu_0 T}{C_H} \left(\frac{\partial m}{\partial T} \right)_H = -\frac{CV}{C_H T} \mu_0 H$$

上式说明在绝热条件下，减少磁场，磁介质的温度会降低，这就成为绝热去磁制冷效应

不忽略体积功

$$\delta W = -PdV + \mu_0 H dm$$

- 基本方程

$$\begin{aligned} dG &= -SdT + VdP - \mu_0 m dH \\ G &= U - TS + PV - \mu_0 m H \end{aligned}$$

- 麦氏关系（磁致伸缩效应）

通过基本方程的二次交换变量求导，可以得到：

$$\left(\frac{\partial V}{\partial H}\right)_{T,p} = -\mu_0 \left(\frac{\partial m}{\partial P}\right)_{T,H}$$

左方偏导数给出体积随磁场的变化率，描述了磁致伸缩效应；右方偏导数给出了磁矩随压强的变化率，描述了压磁效应。

内容补充

广义功

- 液体表面薄膜

$$\delta W = \sigma dA$$

其中 σ 为单位长度的表面张力，A为面积

- 电介质

$$\delta W = Vd\left(\frac{\epsilon_0 E^2}{2}\right) + VE dP$$

- 磁介质

$$\delta W = Vd\left(\frac{\mu_0 H^2}{2}\right) + \mu_0 V H dM$$

- 联立下面四条方程即可推导得到

$$\delta W = V I dt, \quad V = N \frac{dAB}{dt}$$

$$NI = Hlm, \quad B = \mu_0(H + M)$$

物态方程

- 理想气体

$$PV = nRT$$

- 范式气体

$$\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

其中 a , b 为常量

- 昂尼斯方程（近似表达展开）

$$p = \left(\frac{nRT}{V}\right) \left[1 + \frac{n}{V}B(T) + \left(\frac{n}{V}\right)^2 C(T)\right]$$

其中 B 、 C 、...都是位力系数。

- 简单固体和液体

$$V(T, P) = V_0(T_0, 0)[1 + \alpha(T - T_0) - \kappa_T \cdot P]$$

其中两个系数分别为体积膨胀系数、等温压缩系数，可以通过实验测得

- 顺磁固体（居里定律）

$$f(M, H, T) = 0$$

$$M = \frac{CH}{T}$$